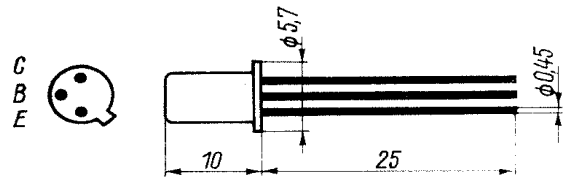


Rauscharmer Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Vor- und Treiberstufen in NF-Verstärkern.



Masse ca. 0,8 g

Wärmewiderstand	R_{thja}	$\leq 0,38$ grad/mW
Wärmewiderstand	R_{thjc}	$\leq 0,05$ grad/mW

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	$= 25$ V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	$= 20$ V
$R_{BE} = 1$ k Ω		
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EB}$	$= 10$ V
Kollektorstrom	$-I_C$	$= 150$ mA
Basisstrom	$-I_B$	≤ 50 mA
Sperrschichttemperatur	θ_j	$= +80$ °C
Betriebstemperaturbereich		-25 °C bis $+65$ °C

8.69

31

Statische Kennwerte

		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		$9 \mu A$	$18 \mu A$
$-U_{CB} = 15$ V				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CER}$		$25 \mu A$	$100 \mu A$
$-U_{CER} = 20$ V				
$R_{BE} = 1$ k Ω				
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$			$200 \mu A$
$-U_{EB} = 10$ V				

Dynamische Kennwerte

Übergangsfrequenz	f_T	$1,2$ MHz		
$-U_{CE} = 6$ V				
$-I_C = 2$ mA				
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21e}	45		90
$-U_{CE} = 6$ V		71		140
$-I_C = 2$ mA		112		224
$f = 1$ kHz				

Rauschmaß

$-U_{CE} = 6$ V				
$-I_C = 0,3$ mA				
$R_o = 500 \Omega$				
$f = 1$ kHz				
$\Delta f = 1$ kHz				
F				5 dB

Vierpolparameter

$-U_{CE} = 6$ V	h_{11e}	$0,54$ k Ω		$2,1$ k Ω	c
$-I_C = 2$ mA	h_{11e}	$0,85$ k Ω		$3,3$ k Ω	d
$f = 1$ kHz	h_{11e}	$1,35$ k Ω		$5,3$ k Ω	e
	h_{12e}			$20 \cdot 10^{-4}$	
	h_{22e}			$200 \mu S$	

Stromverstärkungsgruppe

Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe d

Transistor GC 118 d

8.69

32

Transistoren in ruhender Luft

1. ohne Kühlblech
2. mit Kühlkörper TGL 200—8420 Form G
3. mit AL-Kühlblech, 2 mm dick, A = 9 cm²
vertikal, blank, unbearbeitet
4. vertikal, blank, unbearbeitet A = 25 cm²
5. vertikal, blank, unbearbeitet A = 100 cm²
6. mit angenähert idealer Kühlung

